新製品

SANYO

2SC3455

シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ
スイッチング電源用

暫定規格

特長・高耐圧，高信頼性である。
- スイッチングスピードが速い。（tf ： typ 0.1μs）
- ASOが広い。
- MBITプロセス採用

用途・スイッチング電源用

絶対最大定格／Ta＝25℃

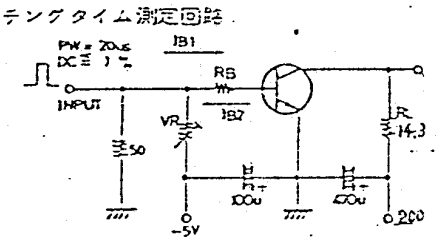
				unit
コレクタ・ベース電圧	VCBO		800	V
コレクタ・エミッタ電圧	VCEO		500	V
エミッタ・ベース電圧	VEBO		7	V
コレクタ電流	IC		25	A
ピークコレクタ電流	icp ※		40	A
ベース電流	IB		8	A
コレクタ損失	PC	TC ＝25℃	160	W
接合部温度	Tj		150	℃
保存周囲温度	Tstg		−55～＋150	℃

※パルス　PW≦ 300μs，Duty Cycle≦10%

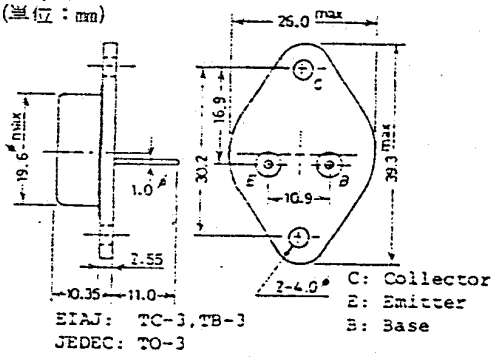
電気的特性／Ta＝25℃

			MIN	TYP	MAX	unit
コレクタしゃ断電流	ICBO	VCB＝500V，IE ＝ 0			10	μA
エミッタしゃ断電流	IEBO	VEB＝ 5V，IC ＝ 0			10	μA
直流電流増幅率	hFE (1)	VCE＝ 5V，IC ＝2.4A	10			
	hFE (2)	VCE＝ 5V，IC ＝12A	8			
利得帯域幅積	fT	VCE＝ 10V，IC ＝2.4A		18		MHz
出力容量	Cob	VCB＝ 10V，f ＝1MHz		320		PF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE (sat)	IC ＝ 12A，IB ＝2.4A			1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	VBE (sat)	IC ＝ 12A，IB ＝2.4A			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	V (BR) CBO	IC ＝ 1mA，IE ＝ 0	800			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V (BR) CEO	IC ＝ 5mA，RBE＝∞	500			V
エミッタ・ベース降伏電圧	V (BR) EBO	IE ＝ 1mA，IC ＝ 0	7			V
コレクタ・エミッタ維持電圧	VCEO (sus)	IC ＝ 20A，IB ＝4A L ＝50μH	500			V
〃	VCEX (sus)	IC ＝10A IB1＝－IB2＝4A L＝ 200μH，Clamped	500			V
上昇時間	ton	VCC＝200V， 5IB1＝－2.5IB2＝IC＝14A RL ＝14.3Ω			0.5	μs
蓄積時間	tstg				3.0	μs
下降時間	tf				0.3	μs

スイッチングタイム測定回路



外形図
(単位：mm)



これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

東京三洋電機株式会社
半導体事業部TD部